Present status of a Cs-Te Photo Cathode RF-Gun at Waseda University

Tatsuya Suzuki^{A)}, Chiaki Igarashi^{A)}, Junji Urakawa^{B)}, Shigeru Kashiwagi^{E)}, Yuta Kato^{A)}, Yoshio Kamiya^{D)}, Masao Kuriki^{F)}, Ryunosuke Kuroda^{C)}, Tomoko Gowa^{A)}, Kazuyuki Sakaue^{A)}, Toshikazu Takatomi^{B)}, Nobuhiro Terunuma^{B)}, Tomoaki Nomoto^{A)}, Yoshimasa Hama^{A)}, Hitoshi Hayano^{B)}, Tachishige Hirose^{A)}, Akihiro Fujita^{A)}, Akihiko Masuda^{A)}, Aki Murata^{A)}, Masakazu Washio^{A)}
A) Research Institute for Science and Engineering, Waseda University (RISE) 3-4-1, Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo, 169-0072
B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

1-1, Oho, Tsukuba-shi, Ibaraki, 305-0801

C) National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)

1-1-1, Umezono, Tsukuba-shi, Ibaraki, 305-8568

D) International Center for Elementary Particle Physics, The University of Tokyo (ICEPP)

7-3-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0033

E) The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University (ISIR)

8-1, Mihogaoka, Ibaraki-shi, Osaka, 567-0047

F) Graduate School of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima University

3-1, Kagamiyama, Higashihiroshima-shi, Hiroshima, 739-8530

Work supported by MEXT High Tech Research Project HRC707, JSPS Grant-in-Aid for Scientific Research (B)(2)

16340079

Abstract

At Waseda University, we have developing an improved type photo cathode RF-Gun which has a Cs-Te cathode with high quantum efficiency. With a new RF-Gun, we can achieve a high current and high energy electron beam, moreover a multi-bunch electron beam can be produced because of its high quantum efficiency. That enables us to extend the range of electron beam parameters for our application experiments. In this conference, we will report the present status and future plans of a Cs-Te photo cathode RF-Gun at Waseda University.

早稲田大学におけるCs-TeフォトカソードRF電子銃の現状

1. はじめに

フォトカソードRF電子銃は近年低エミッタンスか つ短パルスな電子ビームの生成が可能な高輝度電子 源として注目されている。早稲田大学では、これま で使用されていたCuカソードに代えて高量子効率を 持つCs-Teカソードを導入するため、カソード交換 システムを備えた改良型フォトカソードRF電子銃空 胴をKEKと共同で開発した。改良型RF電子銃では、 高量子効率であるCs-Teカソードを用いることによ り、これまでよりも高電荷量の電子ビームの生成が 可能になると共に、マルチバンチ電子ビームの生成 が可能となると期待される。

早稲田大学ではフォトカソードRF電子銃によって 生成した電子ビームを用いて、逆コンプトン散乱を 用いた軟X線生成実験[1]、放射線化学初期過程解明 のためのパルスラジオリシス実験[2]等の応用実験 を行っている。改良型RF電子銃の導入により、高電 荷量の電子ビーム生成が可能になることで、パルス ラジオリシス実験のS/Nの向上が見込まれ、より小 さな変化を伴う放射線化学反応の解析が可能となる。 また、マルチバンチビームを生成することで、逆コ ンプトン散乱における単位時間当たりの衝突回数の 向上によって、約2桁程度のX線生成光子数の増大が 見込まれる。

本講演では、早稲田大学における改良型Cs-Te フォトカソードRF電子銃の現状と今後の展望につい て報告する。

2. 改良型RF電子銃

- 2.1 新RF電子銃における改善点 新しいRF電子銃の製作を行うにあたり主に以下の 4つの点について改善を行った。
- ①Cs-Teカソードの導入
 ②カソード交換システムの導入
 ③ヘリコフレックスシールの除去
 ④チューナー構造の改善

2.2 Cs-Teカソード

新たに導入したCs-Teカソードの特徴としてまず 高量子効率を持つということがあげられる。量子効 率はカソードの質を評価する値で以下のような式で 定義される。

この量子効率の値が以前のCuカソードに比べて2 桁程度高い値(Cu:10⁻⁴~10⁻⁵程度、Cs-Te:10⁻²程度) をとる。そのため、低出力のレーザーで高電荷量を 持ったビームの生成が可能となる。しかし、寿命が 短く、比較的短期間でカソードの交換が必要となる ことや、酸素に触れることで量子効率が大幅に低下 してしまうなどの欠点のため、全ての操作を超高真 空下(10⁻⁷Pa程度)で行えるカソード交換システムを 付属した。

2.3 改良型RF電子銃空胴

旧RF電子銃では図2.1左上に示すようにエンドプ レートとハーフセルをヘリコフレックスシールと SUSプレートを介した締め付けによって接続し、 の締め付けトルクによってハーフセルの周波数を調 整していた。しかし、この構造によって生じる隙間 が放電の大きな要因の一つであると考えられていた。 そこで、図2.1右上に示す新しい空胴ではヘリコフ レックスシールを除去し、ロウ付け処理を施すこと でなるべく穴の少ない構造とし、放電を抑制した。 また、新空胴ではヘリコフレックスシールで行って いたハーフセルの周波数調整ができなくなったため、 ハーフセル、フルセルにそれぞれ4つずつチュー ナーを備え付けた。新しいチューナーは図2.1右下 に示すように空胴壁に穴を開けずに外部のロッドを 上下させ空胴壁を変形させることで周波数調整を行 う構造とし放電の抑制を行った。



図2.1 新RF電子銃空胴概念図

3. 新空胴性能評価試験

空胴の評価として加速空胴の質を表すQ値とR/Qの 測定を行った。Q値とR(シャントインピーダンス)は 以下のような式で定義される。ここでω₀は空胴の 共振角周波数である。

$$\mathbf{Q} = \omega_0 \frac{空胴内の蓄積エネルギー}{1周期あたりのエネルギー損失} (2)$$

$$R = \frac{(空胴内の有効加速電圧)^2}{消費電力}$$
(3)

この式からわかるようにQ値、Rが高いほど同程度のRFを印加した際にもより強い電場で電子ビームを加速することができる。また、R/Qは空胴の形状にのみ依存する値となっている。

3.1 Q值測定

Q値の測定はネットワークアナライザーを用いた 反射法及び透過法によって行った。以下にその結果 を示す。



この結果から得られたπモードの共振周波数及び Q値の値は以下の通りである。

表1.Q值測定結果		
共振周波数	2854.87[MHz]	
Q值	12228.1	

この結果より空胴構造の改良によってQ値が以前のRF電子銃の約8000に比べ、大幅に増加したことが 確認できた。

3.2 R/Q測定

R/Qの測定は図3.3に示すようなセットアップを用いてビーズ摂動法によって行った。



図3.3 ビーズ摂動法セットアップ図 微小な摂動として空胴中心を体積ΔV、半径rの導 体球のビーズを移動させ、摂動のない場合の周波数 からの共振周波数変化をネットワークアナライザー で計測した。周波数変化を求めることによりR/Qを 求めることができ、次式で与えられる。

$$\frac{\mathrm{R}}{\mathrm{Q}} = \frac{\left|\int \sqrt{\left|\Delta \mathbf{f}\right|} \mathrm{d}\mathbf{z}\right|^2}{\pi \mathbf{f}_0^2 \varepsilon \ \Delta \mathrm{V}} \quad (4)$$

ここで ε はビーズの誘電率である。図3.4に空胴 内電場分布の結果を示す。



図3.4 空胴内電場分布測定結果

この結果から求めたR/Q及び、Q値とR/Qの値から 算出したシャントインピーダンスRを以下に示す。

表3.2	R/Q及びR測定結果
R/Q	356[Ω]
R	4.4[M Ω]

以前のRF電子銃に比べシャントインピーダンスR が大幅に増加(3.7→4.4MΩ)したことが確認できた。

3.3 暗電流測定

RF電子銃空胴へ大電力のRFを印可した際には電界 電子放出に依る暗電流が発生する。暗電流が多くな ることで放電などの問題から印可するRFの限界が低 く抑えられることや、応用実験におけるノイズの増 加につながってしまうなどの問題が生じる。図3.5 に新RF電子銃における暗電流の測定結果と旧RF電子 銃での測定結果の比較を示す。



以前のRF電子銃に比べ高い加速電場における暗電 流が低い値となり、新空胴で暗電流の削減に成功し たといえる。 4. 電子ビームパラメータ測定

次に、新RF電子銃を用いて生成した電子ビームの パラメータ測定として電荷量及びエネルギーの測定 を行った。測定結果を図4.1、新RF電子銃での測定 結果と旧RF電子銃での測定結果の比較を表4.1に示 す。



図4.1 電荷量・エネルギー測定結果

表4.1 ビームパラメータ比較

	旧RF電子銃	新RF電子銃
電荷量	370pC	4000pC
エネルギー	4.6MeV	5.3MeV

表4.1に示すように、Cs-Teカソードの導入により 電荷量が旧RF電子銃の370pC/bunchに比べ、約 4000pC/bunchと大幅に増加した事が確認できた。ま た、空胴のQ値が増加したことによりエネルギーに 関しても4.6MeVから5.3MeVと大幅な増加が確認でき た。

5. まとめと今後の予定

新しいRF電子銃の導入に際し、空胴の改善を 行ったことによってQ値及びシャントインピーダン スRの増加、暗電流の削減に成功した。また、量子 効率の高いCs-Teカソードの導入によって、高電荷 量・高エネルギーのビームの生成に成功した。

今後の予定としてはビームパラメータの測定とし てエミッタンスの測定を行いより高品質なビームの生成 を目指す。その後、マルチバンチビーム化に向けて研究 を進めていく予定である。

参考文献

- [1] C.Igarashi et al, Proceedings of this meeting TP059
- [2] A.Fujita et al,Proceedings of this meeting TP060
- [3] P.Michelato et al, "Characterization of Cs₂Te photoemissive film:formation, spectral responses and pollution" Nucl. Instr. and Meth. in Ph_vs. Res. A 3Y3 (IYY7) 4646468